

УТВЕРЖДАЮ

Директор центра микроэлектроники -
главный конструктор ОАО «Ангстрем»

_____ П.Р. Машевич

«__» _____ 2016 г.

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ
БЕСКОРПУСНАЯ ТИПА

К5506БП9Н4-3669

АДБК.431260.834ТУ

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

ПАКД.431410.025-3669Д16

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог

_____ Л.В. Лысак

«__» _____ 2016 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Дорфман	Перв. примен.											
Справ. №	ПАКД.431139.003											
Гл. метролог												
Бринева	Подп. и дата											
ОГК	Инв. № дубл.											
Глумов	Взам. инв. №											
Цех775060	Подп. и дата											
Инв. № подл.	ПАКД.431410.025-3669Д16											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Микросхема интегральная бескорпусная типа К5506БП9Н4-3669 КАРТА ИЗДЕЛИЯ					Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Гусакова									О ₁	2	5
Пров.	Кечко											
Н. контр.	Дронов											
Утв.	Машевич											

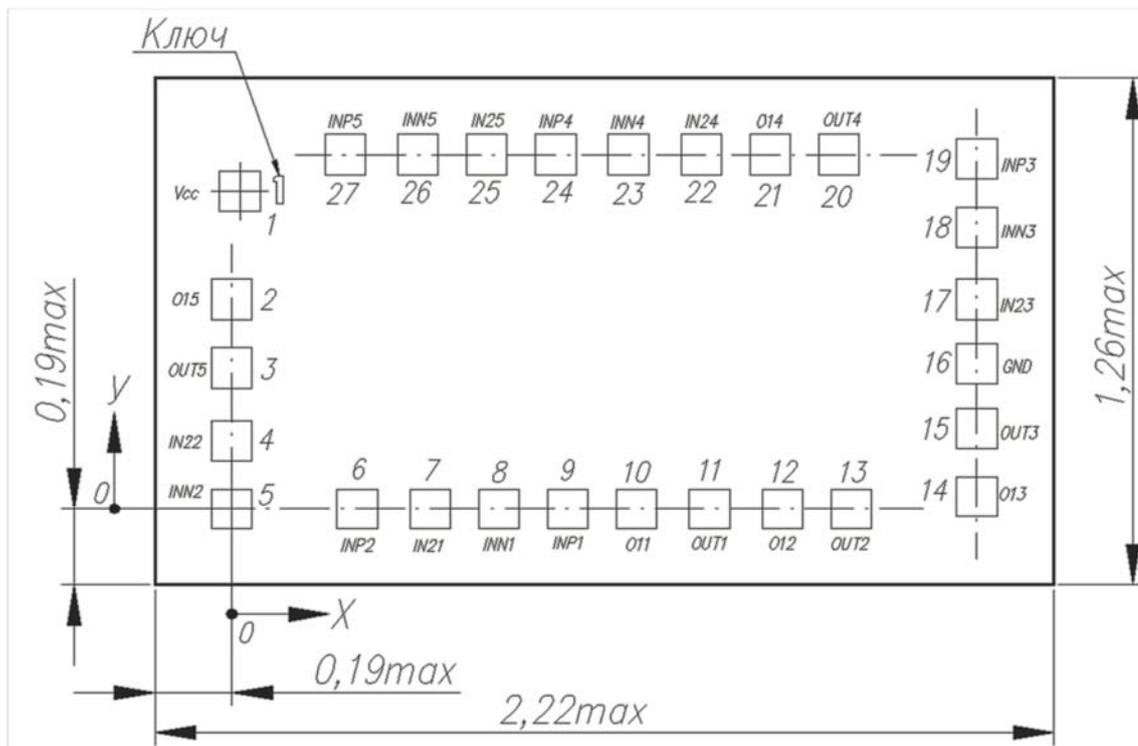
1 Общие положения

- 1.1 Регистрационный номер карты изделия 3669
- 1.2 Обозначение микросхем интегральных бескорпусных (далее микросхем) в конструкторской документации:
К5506БП9Н4-3669 АДБК.431260.834ТУ, карта изделия ПАКД.431410.025-3669Д16.
- 1.3 Обозначение комплекта конструкторской документации на микросхемы ПАКД.431139.003.
- 1.4 Микросхемы К5506БП9Н4-3669 должны удовлетворять требованиям АДБК.431260.834ТУ и карты базовой ПАКД.431410.025-000Д16 с уточнениями и дополнениями, установленными в разделе 2 настоящей карты изделия.

2 Технические требования

- 2.1 Габаритные размеры кристалла должны быть:
 - 2.1.1 А = 2,22 мм, Б = 1,26 мм.
 - 2.1.2 Толщина кристалла: 0,3 мм.

2.2 Расположение контактных площадок (КП) должно соответствовать рисунку 1 и таблице 1.



- 1 Топология кристалла за исключением контактных площадок не показана.
- 2 Обозначение контактных площадок показано условно.
- 3 Минимальный размер контактных площадок (100 x 100) мкм.
- 4 Размер кристалла с учетом дорожки реза (2,22 x 1,26) мм.

Рисунок 1 - Чертеж кристалла

Т а б л и ц а 1 - Координаты центров контактных площадок (КП) кристалла

Номер КП	Обозначение КП	Координаты центра КП	
		X, мм	Y, мм
1	Vcc	0,02	0,79
2	O15	0	0,52
3	OUT5	0	0,35
4	IN22	0	0,17
5	INN2	0	0
6	INP2	0,31	0
7	IN21	0,49	0
8	INN1	0,66	0
9	INP1	0,83	0
10	O11	1,00	0
11	OUT1	1,18	0
12	O12	1,36	0
13	OUT2	1,53	0
14	O13	1,84	0,03

Номер КП	Обозначение КП	Координаты центра КП	
		X, мм	Y, мм
15	OUT3	1,84	0,20
16	GND	1,84	0,36
17	IN23	1,84	0,52
18	INN3	1,84	0,70
19	INP3	1,84	0,87
20	OUT4	1,50	0,88
21	O14	1,33	0,88
22	IN24	1,16	0,88
23	INN4	0,98	0,88
24	INP4	0,80	0,88
25	IN25	0,63	0,88
26	INN5	0,46	0,88
27	INP5	0,28	0,88

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.
Изм.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПАКД.431410.025-3669Д16

Лист

3

2.3 Количество кристаллов на пластине должно быть 5600.

2.4 Электрические параметры микросхем в нормальных климатических условиях при приемке и поставке должны соответствовать нормам, установленным в таблице 2.

Таблица 2 – Электрические параметры микросхем в нормальных климатических условиях при приемке и поставке.

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Погрешность изменения, %, не более	Напряжение питания, U_{CC} , В	Примечания
		не менее	не более			
1	2	3	4	5	6	7
1 Входная чувствительность, мВ	V_{IN}	5	–	± 10	3,9	1
					3,0	
					2,3	
2 Ток потребления, мкА	I_{CC}	20	160	± 5	3,8	–
3 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА	I_{ILL} и I_{ILH}	–	1	± 10	3,8	–
4 Функциональный контроль, мс	ФК	1	50	–	3,9	2
					3,0	
					2,3	

Примечания

- 1 Входная чувствительность контролируется при проведении функционального контроля.
- 2 Тестовый сигнал и значения режимных временных параметров приведены в ПАКД.431139.003ТБ.
- 3 Погрешность установки напряжения питания U_{CC} должна быть не более $\pm 1\%$.
- 4 Погрешность установки временных входных сигналов не более $\pm 5\%$.
- 5 Выходные сигналы контролируют по уровню 0,35 В от исходного уровня выходного сигнала.

2.5 Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем в диапазоне рабочих температур среды должны соответствовать нормам, установленным в таблице 3.

Таблица 3 – Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем в диапазоне рабочих температур среды.

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
1	2	3	4	5	6
1 Напряжение питания, В	U_{CC}	2,4	3,8	–	5
2 Входное напряжение, В	U_{IN}	–	–	–0,3	$U_{CC}+0,3$

2.6 Методики и схемы измерения электрических параметров и проведения ФК приведены в ПАКД.431139.003ТБ.

2.7 Используемые контрольно-измерительные приборы и оборудование приведены в ПАКД.431139.003ТБ.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПАКД.431410.025-3669Д16	Лист
						4

